

пройдут через начало координат. В системах, где условия определения этих величин стандартизованы (например, кристаллогидраты неорганических солей), зависимость типа Беджера — Бауэра является линейной, а ее свободный член практически равен нулю [8]. Все это дает основание считать, что представленная на рис. 3 зависимость — ΔH — Δv не может быть описана единым аналитическим уравнением, а ее якобы квадратичный характер [2], очевидно, является результатом отбора «лучших» экспериментальных значений — ΔH .

Таким образом, анализ двух наиболее известных спектрохимических корреляций показывает, что установление общих закономерностей возможно только путем обобщений, проведенных с учетом и в согласии с имеющимися экспериментальными данными. Очевидно также, что только стандартизация условий определения экспериментальных величин, а также учет структурных особенностей взаимодействующих компонентов позволит выяснить истинный характер этих зависимостей. Только в этом случае сделанные обобщения будут содействовать дальнейшему развитию наших представлений о межмолекулярных взаимодействиях в растворах.

1. Перова Т. С., Либов В. С., Бахшиев Н. Г. О совместном влиянии специфической сольватации на ИК-спектры систем с водородной связью.— Спектроскопия внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Л.: Химия, 1978, вып. 2, с. 156—165.
2. Иогансен А. В. Инфракрасная спектроскопия и спектральное определение энергии водородной связи.— В кн.: Водородная связь. М.: Наука, 1981. с. 112—155.
3. Пильгин В. С. Сопоставление электронодонорной способности гексаметилфосфортриамида, алифатических и ароматических фосфатов и фосфиноксидов.— Журн. общ. химии, 1980, 50, № 4, с. 835—840.
4. Биттман Г. Л., Карабев Ю. З., Эляшберг М. Е. Исследование межмолекулярной ассоциации гидроперекиси третичного бутила с производными бензола методом ИК-спектроскопии.— Там же, 1974, 44, № 6, с. 1361—1366.
5. Перельгин И. С. О корреляциях спектроскопических характеристик Н-комплексов с энергиями водородных связей.— Журн. прикл. спектроскопии, 1977, 26, № 4, с. 718—721.
6. Desmeules P. J., Allen L. C. Strong, positive-ion hydrogen bonds: The binary complexes formed from NH_3 , OH_2 , FH_2 , NH_2 , SH_2 and ClH .— J. Chem. Phys., 1980, 72, N 9, p. 4731—4748.
7. Белобров В. М., Титов Е. В. Некоторые вопросы изучения систем с Н-связями методом ИК-спектроскопии.— В кн.: Проблемы физико-органической химии. Киев: Наук. думка, 1978, с. 45—77.
8. Luck W. A. P. Studies of intermolecular forces by vibrational spectroscopy / Ed. B. Pullman. Dordrecht: Holl. e. a.: D. Reider Publ. Co. Intermolecular Forces. Proc. 14th Symp. Quantum Chem. and Biochem. Jerusalem, Apr. 13—16, 1981, 14, p. 199—215.

Ин-т физ.-орган. химии и углехимии АН УССР,
Донецк

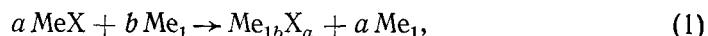
Поступила 09.07.84

УДК 536.77:546.3.19

ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМАХ ТИПА $\text{Al}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ -МЕТАЛЛ

В. И. Грыцив

В технологии полупроводникового материаловедения металлы используют для создания контактов, в качестве растворителей при перекристаллизации монокристаллов тугоплавких соединений и их твердых растворов и как легирующие смеси. Однако их практическое применение ограничивается в случае, если они взаимодействуют с полупроводниковыми соединениями. Обменное взаимодействие типа



где Me и Me_1 — металлы; X — халькоген, усложняет создание и использование приборов. Изучение реакций, описываемых уравнением (1), позволит объяснить причины отклонения работы полупроводниковых приборов от заданного режима.

Таблица 1

Термодинамический прогноз направления протекания обменных реакций между полупроводниками соединениями $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и некоторыми металлами

Соединение	Cu	Ag	Au	Zn	Cd	Hg	Ga	In	Ge	Sn	Pb	As	Sb	Bi
ZnS	+	+			+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
ZnSe	+	+			+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
ZnTe	+	+	+		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
CdS	+	+	-		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
CdSe	+	+	-		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
CdTe	+	-	+	-		+	-	+	+	+	+	+	+	+
HgS	-	+	-	-		-	-	-	-	-	+	-	-	-
HgSe	-	+	-	-		-	-	-	-	-	+	+	-	+
HgTe	-	+	-	-		-	-	-	-	-	+	+	+	+
GeS	+	-	+	-		+	-	-	-	-	+	+	+	+
GeSe	+	-	+	-		+	-	-	-	-	+	+	+	+
GeTe	-	+	-	-		+	-	-	-	-	+	+	+	+
SnS	+	-	+	-		+	-	-	+	-	+	+	+	+
SnSe	+	-	+	-		+	-	-	+	-	+	+	+	+
SnTe	+	-	+	-		+	-	-	+	-	+	+	+	+
PbS	+	-	+	-		+	-	-	+	-	+	+	+	+
PbSe	+	-	+	-		+	-	-	+	-	+	+	+	+
PbTe	+	-	+	-		+	-	-	+	+	+	+	+	+

Цель настоящего исследования — установить направление обменных реакций между полупроводниковыми соединениями типа $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и некоторыми металлами. В работе использовали стандартный изобарно-изотермический потенциал реакций (ΔG^0), который был рассчитан по общепринятой методике. Необходимые термодинамические свойства веществ взяты в основном из работы [1].

Реакция (1) протекает в прямом направлении при $\Delta G^0 < 0$ и смещается в сторону образования исходных веществ, если $\Delta G^0 > 0$. В условиях равновесия $\Delta G^0 = 0$. Таким образом, величина ΔG^0 служит критерием оценки направления обменной реакции при контакте полупроводникового соединения с металлом.

Графически равновесие фаз, описываемое реакцией (1), можно представить полигориеским сечением. Если в системе $Me_1 - MeX$ обменная реакция не протекает, то полигориеское сечение является квазибинарным и называется диаграммой состояния. Имеется много работ по фазовым равновесиям. В настоящей статье было проведено сравнение вида полигориеских сечений, описанных в литературе, с теоретическим прогнозом, проведенным на основании рассчитанных значений ΔG^0 . С одной стороны, это позволит сопоставить результаты теории с экспериментом, с другой — даст критерий для правильного выбора контактирующих пар полупроводник — металл.

Сделан термодинамический прогноз направления обменных реакций между полупроводниковыми соединениями типа $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и некоторыми металлами (табл. 1). В таблице показан общий характер изменения ΔG^0 обменных реакций, описываемых уравнением (1). Пары халькогенид — металл, являющиеся термодинамически стабильными, обменное взаимодействие в которых отсутствует, обозначены знаком «+» ($\Delta G^0 > 0$), контактирующие пары, в которых происходит обменное взаимодействие, обозначены «—» ($\Delta G^0 < 0$). В случаях, когда некоторые реакции не протекают в области низких температур, но, вероятно, должны протекать при высоких температурах, принято обозначение «+—».

Таблица 2
Характер взаимодействия между полупроводниковыми соединениями типа $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и некоторыми металлами

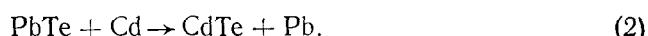
Соединение	Cu	Ag	Au	Zn	Cd	Hg	Ga	In	Ge	Sn	Pb	As	Sb	Bi
ZnS	HK						K*	K*						K*
ZnSe							B9	B9						B9
ZnTe														K*
CdS	HK													K*
CdSe	HK													B9
CdTe	HK													B9
HgS														
HgSe														
HgTe														
GeS														
GeSe	HK[25]	HK[29]												
GeTe														
SnS														
SnSe	HK[15]	HK[28]												
SnTe														
PbS														
PbSe														
PbTe	HK[4]	HK[5]												

Для всех систем на основе халькогенидов цинка, за исключением $ZnX-Ga$, ΔG^0 имеет положительное значение, для пар с участием халькогенидов ртути принимает в основном отрицательные значения. Системы халькогенид кадмия — примесь имеют положительные и отрицательные значения ΔG_0 . Эти результаты показывают характер изменения физико-химического взаимодействия в зависимости от термодинамических свойств и ширины запрещенной зоны соединений. Термодинамические свойства узкозонных полупроводников способствуют взаимодействию их со многими примесями, а широкозонных — только с некоторыми. Примеси, взаимодействующие с широкозонными полупроводниками, все без исключения будут взаимодействовать и с соединениями, имеющими узкую запрещенную зону.

Характер взаимодействия между полупроводниковыми соединениями $A^{II}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и некоторыми металлами по экспериментальным данным некоторых авторов представлен в табл. 2. Сведения о системах с участием халькогенидов цинка, кадмия и ртути приведены в работе [2]. Всего в табл. 2 представлены данные для 68 систем из 234 возможных. Наблюдается совпадение термодинамического прогноза с экспериментальными результатами, за исключением некоторых систем на основе меди и серебра, а также $Zn(Cd)Te-Ga$. Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что имеется значительное количество материала по фазовым равновесиям. Эти результаты могут быть использованы для правильного подбора растворителей при перекристаллизации соединений и выращивании монокристаллов, создания контактов, легирования. Так, монокристаллы халькогенидов цинка, кадмия и их твердых растворов можно получать из раствора в расплаве олова. Однако такой метод не годится для получения кристаллов халькогенидов германия, потому что все они вступают в обменное взаимодействие с оловом. В случае халькогенидов цинка и кадмия *n*-типа можно использовать контакты из индия. Для кристаллов халькогенидов ртути и всех соединений $A^{IV}B^{VI}$ индий в качестве материала для контактов не подходит, поскольку такая пара контактирующих материалов термодинамически нестабильна и может отказывать в работе. Возможно, что дрейф параметров и возникновение шумов в полупроводниковых приборах отчасти вызваны обменным химическим взаимодействием на границе контакта между подложкой и металлом.

На наличие обменного химического взаимодействия следует обращать внимание и при легировании полупроводниковых соединений. В большинстве работ по изучению влияния примесей на гальваномагнитные свойства не указывается, в какой форме введена легирующая примесь в расплав в процессе роста. При диффузионном легировании часто не принимается во внимание форма примеси в газовом или твердом диффундирующем источнике.

На основании результатов настоящей работы можно сделать вывод, что лигатуру необходимо вводить в форме, исключающей обменное взаимодействие между кристаллом и легирующей примесью. Кадмий, например, следует вводить в теллурид свинца не в виде металлического кадмия, а в виде его теллурида, что исключит протекание обменной реакции



При условии, что обменная реакция (2) протекает до конца, введение 10^{24} атом· m^{-3} кадмия приведет к образованию эквивалентного количества избыточного свинца, то есть к значительному возрастанию дефектов кристаллической решетки. Однако в литературе нет однозначного ответа на вопрос, обладал ли бы кристалл необходимыми свойствами, если бы в нем отсутствовали дефекты, вызванные обменным химическим взаимодействием. Возможно, что именно эти дефекты, образующиеся в процессе обменной реакции (реакционные дефекты), или их комплексы с примесью приводят к появлению у кристаллов необходимых свойств, делающих пригодными их для практического

применения. Обменное химическое взаимодействие должно влиять и на сегрегацию компонентов в растущем кристалле. Каждая молекулярная форма примеси характеризуется своим коэффициентом распределения.

1. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ: Справочник / Под ред. А. В. Новоселовой и др.—М.: Наука, 1979.—339 с.
2. Томашик В. Н., Грицив В. И. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений $\text{Al}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$. Справочник.—Киев: Наук. думка, 1982.—167 с.
3. Vogel R. Über das System Blei — Silber — Schwefel.—Z. Metallkunde, 1953, **44**, N 4, S. 133—135.
4. Gravermann H., Wallbaum H. J. Zur Kenntnis des Dreistoff-systems Kupfer — Blei — Tellur.—Ibid., 1956, **47**, N 6, S. 433—441.
5. Bates H. E., Wald F., Weinstein M. The compatibility of tin telluride with metals.—Adv. Energy Convers., 1968, **7**, N 4, p. 275—287.
6. Абрикосов Н. Х., Скуднова Е. В., Порецкая Л. В. Исследование разрезов SnTe — Sb и SnTe — SnSb в тройной системе Sn — Te — Sb .—Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1968, **4**, № 10, с. 1670—1675.
7. Исследование системы Sb — Pb — Te / Н. Х. Абрикосов, Е. В. Скуднова, Л. В. Порецкая, Т. А. Осипова.—Там же, 1969, **5**, № 4, с. 741—745.
8. Arkoosh M. A., Peretti E. A. The system SnTe — As .—Trans. Metallurg. Soc. AIME, 1969, **245**, N 6, p. 1363—1366.
9. Исследование системы Bi — Pb — Te / Н. Х. Абрикосов, Е. В. Скуднова, Л. В. Порецкая, Т. А. Осипова.—Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1969, **5**, № 10, с. 1682—1686.
10. Абрикосов Н. Х., Данилова-Добрякова Г. Т. Исследование тройной системы Ge — Sb — Te .—Там же, 1970, **6**, № 3, с. 475—481.
11. Абрикосов Н. Х., Данилова-Добрякова Г. Т. Система Ge — Bi — Te .—Там же, № 10, с. 1798—1803.
12. Заргарова М. И., Акперов М. М. Фазовые равновесия в тройной системе Ga — Ge — Te .—Азерб. хим. журн., 1972, № 2, с. 124—129.
13. Legendre B., Souleau C. Le système ternaire argent — plomb — sélénium.—Bull. Soc. chim. France, 1972, N 2, p. 463—472.
14. Legendre B., Souleau C. Etude du système ternaire Au — Pb — Te .—Ibid., p. 473—479.
15. Исследование разреза (40 ат. % Cu —60 ат. % Se)— Sn / Л. И. Бергер, Е. Г. Котина, Ю. В. Обозненко, Л. Е. Ободовская.—Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1973, **9**, № 2, с. 222—225.
16. Заргарова М. И., Акперов М. М. Фазовые равновесия в тройной системе In — Ge — Te .—Там же, № 7, с. 1138—1141.
17. Физико-химическое изучение системы Pb — Sn — Se / З. М. Латыпов, В. П. Савельев, В. П. Зломанов, В. В. Парфенов.—В кн.: Физико-химическое изучение неограниченных реакций. Чебоксары, 1976, в. 3, с. 135—140.
18. Eppelsheimer D. Investigations within the tin — antimony — sulfur system.—Neues. Jahrb. Mineral. Monatsh., 1974, N 11, p. 526—529.
19. Поля кристаллизации в системе Ge — As — Te / Г. З. Виноградова, С. А. Дембовский, А. Н. Копейкина, Н. П. Лужная.—Журн. неорган. химии, 1975, **20**, № 5, с. 1367—1372.
20. Заргарова М. И., Каҳраманов К. Ш., Рошаль Р. М. Система PbS — Sb .—Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1975, **11**, № 6, с. 1138—1139.
21. Legendre B., Geolin R., Souleau C. Le système ternaire Au — Sn — Te .—Bull. Soc. Chim. France, 1975, N 11/12, p. 2475—2480.
22. Рустамов П. Г., Гаджисева А. З., Мардахаев Б. Н. Система In — Sn — Se .—Журн. неорган. химии, 1976, **21**, № 2, с. 518—521.
23. Рустамов П. Г., Бабаева В. К. Исследование тройной системы In — Ge — Se .—Азерб. хим. журн., 1976, № 3, с. 75—79.
24. Carcaly C., Rivet J., Flahaut J. Description du système ternaire Cu — Sn — Te .—J. Less-Common Metals, 1975, **41**, N 1, p. 1—18.
25. Description du système ternaire Cu — Ge — Te / M. Dogguy, C. Carcaly, J. Rivet, J. Flahaut.—Ibid., 1977, **51**, N 2, p. 181—199.
26. Rouland J.-Ch., Legendre B., Souleau C. The ternary system Gold—Lead—Selenium.—J. Chem. Res. Synop., 1977, N 10, p. 242—243.
27. Меликова З. Д., Рустамов П. Г. Система InSe — Pb и PbSe — In .—Журн. неорган. химии, 1977, **22**, № 10, с. 2877—2879.
28. Legendre B., Rouland J. C., Souleau C. Le système ternaire Au — Ge — Te .—C. r. Acad. sci., 1977, **284**, N 12, p. 451—454.
29. Blachnik R., Gather B. Mischungen von GeTe , SnTe und PbTe mit Ag_2Te ein Beitrag zur Klärung der Konstitution der ternären Ag — IYb — Te Systeme ($\text{IYb} = \text{Ge}$, Sn , Pb).—J. Less-Common Metals, 1978, **60**, N 1, p. 25—32.
30. Шер А. А., Один И. Н., Новоселова А. В. Исследование взаимодействия в системе Sn — Bi — Se .—Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1978, **14**, № 7, с. 1270—1276.
31. Грицив В. И. Политермическое сечение PbTe — Cd .—Там же, 1980, **16**, № 3, с. 545—546.
32. Рустамов П. Г., Меликова З. Д. Ликвидус тройной системы In — Pb — S .—Журн. неорган. химии, 1981, **26**, № 5, с. 1432—1434.

Житомир. пед. инт

Поступила 28.05.84